

УКРАЇНА

UKRAINE



# ПАТЕНТ

НА ВИНАХІД

№ 89385

## СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБЛАСТІ ІСНУВАННЯ НЕСПІВМІРНОЇ ФАЗИ В ФЕРОЇКАХ

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на винаходи  
**25.01.2010.**

Голова Державного департаменту  
інтелектуальної власності

М.В. Паладій





УКРАЇНА

(19) UA (11) 89385 (13) C2  
(51) МПК (2009)  
G01K 17/00

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  
І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ  
ІНТЕЛІКЕРУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ

## ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД

(54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ОБЛАСТІ ІСНУВАННЯ НЕСПІВМІРНОЇ ФАЗИ В ФЕРОЇКАХ

1

2

(21) a200703896

(22) 10.04.2007

(24) 25.01.2010

(46) 25.01.2010, Бюл.№ 2, 2010 р.

(72) СЛИВКА ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ, СТУДЕНЯК ІГОРЬ ПЕТРОВИЧ

(73) ДЕРЖАВНИЙ ВИЦІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

(56) UA 78057 C2, 15.02.2007, весь документ

Парсамян Т. К., Хасанов С.С., Шехтман В. Ш., Высоцянский Ю.М., Сливка В.Ю. Несоразмерная фаза в собственном сегнетоэлектрике Sn<sub>2</sub>P<sub>2</sub>Se<sub>6</sub> //Физика твердого тела. - 1985. - Т.27, №11. - С.3327-3331

UA 13684 U, 17.04.2006, весь документ

UA 15135 U, 15.06.2006, весь документ

UA 17695 U, 16.10.2006, весь документ

Гридинев С.А. Сюрпризы несоразмерной фазы в сегнетоэлектриках. Источник:

<http://www.rfbr.ru/pics/28423ref/file.pdf>

(57) Способ визначення температурної області існування неспівмірної фази в фероїках, який включає експериментальні дослідження оптичних властивостей фероїків, який відрізняється тим, що проводять температурні дослідження краю оптичного поглинання в фероїках і представляють енер-

гетичну ширину  $w$  краю оптичного поглинання у вигляді

$$w = w_T + (w_X)_{\text{stat}} + (w_X)_{\text{dyn}},$$

після чого визначають внески температурного  $w_T$ , статичного структурного розупорядкування  $(w_X)_{\text{stat}}$  та динамічного структурного розупорядкування  $(w_X)_{\text{dyn}}$  при певній температурі  $T$  за отриманими при описі температурної залежності  $w$ 

$$\text{за формулою } w = w_0 + w_1 \left[ \frac{1}{\exp(\theta_E / T) - 1} \right]$$

параметрами  $w_0$  і  $w_1$  та температурою Ейнштейна  $\theta_E$  як

$$w_T = w_1 / [\exp(\theta_E / T) - 1], \quad (w_X)_{\text{stat}} = \\ = w_0, \quad (w_X)_{\text{dyn}} = w - w_T - (w_X)_{\text{stat}},$$

а далі за температурною областю, для якої справдіється умова  $(w_X)_{\text{dyn}} \neq 0$ , а також має місце паралельне довгохвильове зміщення краю оптичного поглинання та температурна незмінність енергетичної ширини краю оптичного поглинання, визначають область існування неспівмірної фази в фероїках.

Винахід відноситься до області фізики твердо-го тіла, зокрема до способів дослідження фазових переходів в фероїках, і може бути використаний як ефективний та надійний спосіб визначення області існування неспівмірної фази шляхом температурних досліджень краю оптичного поглинання в фероїках.

Відомо, що для багатьох твердих тіл погли-нання поблизу краю оптичного поглинання зростає за експоненціальним законом. Більше того, для ряду твердих тіл було встановлено, що температурно-спектральна залежність коефіцієнта погли-нання  $\alpha$  описується правилом Урбаха [1]:

$$\alpha(hv, T) = \alpha_0 \cdot \exp \left[ \frac{hv - E_0}{w(T)} \right], \quad (1)$$

де  $w$  - енергетична ширина краю оптичного по-глинання;  $\alpha$  та  $E_0$  - координати точки збіжності урбахівського "віяла";  $hv$  - енергія кванта падаючо-го світла;  $T$  - температура. Температурна поведінка енергетичної ширини  $w$  в моделі Ейнштейна описується за допомогою співвідношення [2]:

$$w = w_0 + w_1 \left[ \frac{1}{\exp(\theta_E / T) - 1} \right], \quad (2)$$

де  $w_0$  та  $w_1$  - деякі постійні величини,  $\theta_E$  - тем-пература Ейнштейна, яка відповідає усередненій частоті фононних збуджень системи невзаємодію-чих осциляторів.

Енергетична ширина урбахівського краю опти-чного поглинання в твердих тілах, як відомо, ви-значається не тільки температурним, але й струк-турним розупорядкуванням [3]:

(13) C2

(11) 89385  
(19) UA

$$w(T, X) = K \left( \langle u^2 \rangle_T + \langle u^2 \rangle_X \right), \quad (3)$$

де  $K$  - константа,  $\langle u^2 \rangle_T$  та  $\langle u^2 \rangle_X$  - середньо-квадратичні відхилення (зміщення) атомів від їх рівноважних позицій, викликані відповідно температурним та структурним розупорядкуванням твердотільної системи. Оскільки зміщення атомів від рівноважних позицій веде до зміни електричного потенціалу системи, то формулу (3) записують як

$$w = k_0 (W_T^2 + W_X^2) = w_T + w_X, \quad (4)$$

де  $k_0$  - константа,  $W_T^2$  та  $W_X^2$  - середньоквадратичні відхилення від електричного потенціалу ідеально впорядкованої структури, викликані відповідно температурним та структурним розупорядкуванням, а внески температурного  $w_T$  та структурного  $w_X$  розупорядкування в  $w$  вважаються незалежними, еквівалентними та адитивними. Структурне розупорядкування у твердих тілах можна представити у вигляді суми двох складових - статичного структурного розупорядкування ( $w_X$ )<sub>stat</sub> та динамічного структурного розупорядкування ( $w_X$ )<sub>dyn</sub>, причому внесок температурно-незалежного статичного структурного розупорядкування ( $w_X$ )<sub>stat</sub> викликаний наявністю різного роду дефектів, домішок та неоднорідностей кристалічної структури, тоді як внесок температурно-залежного динамічного структурного розупорядкування ( $w_X$ )<sub>dyn</sub> викликаний наявністю, наприклад, міграційного руху іонів в твердих електролітах або модуляцією структури в фероїках.

Однак, в деяких твердих тілах спостерігається відхилення від урбахівської поведінки краю поглинання. Так, наприклад, при дослідженні краю оптичного поглинання сегнетоелектрика  $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{Se}_6$  виявлено три характерні температурні області: область урбахівської поведінки краю поглинання при  $T < 195\text{K}$ , область паралельного довгохвильового зміщення краю оптичного поглинання в інтервалі температур  $195 \leq T \leq 220\text{K}$  та область урбахівської поведінки краю поглинання при  $T > 220\text{K}$  [4]. Паралельне зміщення краю оптичного поглинання в  $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{Se}_6$  пов'язується з наявністю модуляції структури в неспівмірній фазі у вказаній температурній області.

Найбільш близьким до запропонованого способу визначення температурної області існування неспівмірної фази в фероїках є рентгенодифракційний метод, який полягає у вимірюванні дифрактограм рентгенівського випромінювання при різних температурах та послідуочному аналізі положень, півширин та інтенсивностей основних і сателітних рефлексів [5].

Недоліком методу є його трудомісткість та складність, пов'язані з проведенням низькотемпературних рентгеноструктурних досліджень та необхідністю забезпечення високоточних прецизійних вимірювань.

Завданням винаходу є створення способу визначення температурної області існування неспівмірної фази в фероїках, який дозволяв би надійно та ефективно ідентифікувати наявність неспівмір-

ної фази в фероїках шляхом температурних досліджень краю оптичного поглинання.

Поставлене завдання досягається таким чином, що запропоновано спосіб визначення температурної області існування неспівмірної фази в фероїках шляхом температурних досліджень краю оптичного поглинання, який включає експериментальні дослідження оптичних властивостей фероїків, який відрізняється тим, що, проводять температурні дослідження краю оптичного поглинання в фероїках і представляють енергетичну ширину  $w$  краю оптичного поглинання у вигляді

$$w = w_T + (w_X)_{\text{stat}} + (w_X)_{\text{dyn}}, \quad (5)$$

після чого визначають внески температурного  $w_T$ , статичного структурного розупорядкування ( $w_X$ )<sub>stat</sub> та динамічного структурного розупорядкування ( $w_X$ )<sub>dyn</sub> при певній температурі  $T$  за отриманими при описі температурної залежності  $w$  за формулою (2) параметрами  $w_0$ ,  $w_1$  та температурою Ейнштейна  $\theta_E$

$$w_T = w_1 / [\exp(\theta_E / T) - 1], \quad (w_X)_{\text{stat}} = \\ = w_0, \quad (w_X)_{\text{dyn}} = w - w_T - (w_X)_{\text{stat}}, \quad (6)$$

де  $w_0$ ,  $w_1$  - деякі постійні величини, а далі за температурною областю, для якої справджується умова  $(w_X)_{\text{dyn}} \neq 0$ , а також має місце паралельне довгохвильове зміщення краю оптичного поглинання та температурна незмінність енергетичної ширини краю оптичного поглинання, визначають область існування неспівмірної фази в фероїках.

Запропонований спосіб визначення температурної області існування неспівмірної фази в фероїках, у порівнянні зі способом-прототипом, є менш трудомістким та більш інформативним, який на основі температурних досліджень краю оптичного поглинання дозволяє надійно та ефективно ідентифікувати існування неспівмірної фази в фероїках.

Спосіб здійснюється наступним чином: спектрометричним методом досліджають спектральні залежності коефіцієнтів поглинання в фероїках при різних температурах. Потім розраховують енергетичну ширину краю оптичного поглинання  $w$ , а її температурну залежність апроксимують співвідношенням (2). За отриманими при описі експериментальної залежності  $w(T)$  параметрами  $w_0$ ,  $w_1$  та  $\theta_E$  за допомогою співвідношень (2) і (6) визначають внески температурного  $w_T$ , статичного ( $w_X$ )<sub>stat</sub> та динамічного ( $w_X$ )<sub>dyn</sub> структурного розупорядкування. Температурна область, для якої справджується умова  $(w_X)_{\text{dyn}} \neq 0$ , має місце паралельне довгохвильове зміщення краю оптичного поглинання та температурна незмінність енергетичної ширини краю поглинання, являється областю існування неспівмірної фази в фероїках.

Приклад конкретного використання запропонованого способу.

За допомогою запропонованого способу ідентифіковано область існування неспівмірної фази в сегнетоелектрику  $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{Se}_6$ . Відомо, що в цьому кристалі реалізуються два низькотемпературні фазові переходи, один з яких є фазовим переходом із параелектричної фази в неспівмірні при

$T=T_i$ , другий - фазовим переходом із неспівмірної в сегнетоелектричну при  $T=T_c$  [4]. Спектральні залежності коефіцієнтів пропускання  $T$  та відбивної здатності  $r$  досліджувалися за допомогою ґраткового монохроматора МДР-3, а значення коефіцієнтів поглинання  $\alpha$  розраховувалися за формулою

$$\alpha = \frac{1}{d} \ln \left[ \frac{(1-r)^2 + \sqrt{(1-r)^4 + 4T^2 r^2}}{2T} \right], \quad (7)$$

де  $d$  - товщина зразка. Характерне урбахівське "віяло" для кристала  $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{Se}_6$  наведено на фіг. 1. Потім розраховувалися значення енергетичної ширини експоненціального краю поглинання як  $w = \Delta(h\nu) / \Delta(\ln\alpha)$ , температурна залежність якої наведена на фіг. 2. Одержанна температурна залежність  $w$  апроксимувалася за формулою (2) і визначалися внески температурного  $w_t$ , статичного ( $w_x$ )<sub>stat</sub> та динамічного ( $w_x$ )<sub>dyn</sub> структурного розупорядкування за формулами (2) і (6). За результатами дослідження встановлено, що в  $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{Se}_6$  неспівмірна фаза існує в інтервалі температур  $195 \leq T \leq 220 \text{ K}$ , тобто у вказаному інтервалі температур справджується умова  $(w_x)_{dyn} \neq 0$ , має місце паралельне довгохвильове зміщення краю оптичного поглинання та температурна незмінність енергетичної ширини краю поглинання (фіг. 2). Наявність динамічного структурного розупорядкування ( $w_x$ )<sub>dyn</sub> у неспівмірній фазі сегнетоелектрика

$\text{Sn}_2\text{P}_2\text{Se}_6$  зумовлена хвилею модуляції, параметри модуляції якої залежні від температури.

Винахід може бути використаний у науково-дослідних лабораторіях при дослідженнях параметрів краю оптичного поглинання в фероїках з метою їх використання у ролі функціональних елементів для оптоелектроніки.

Джерела інформації:

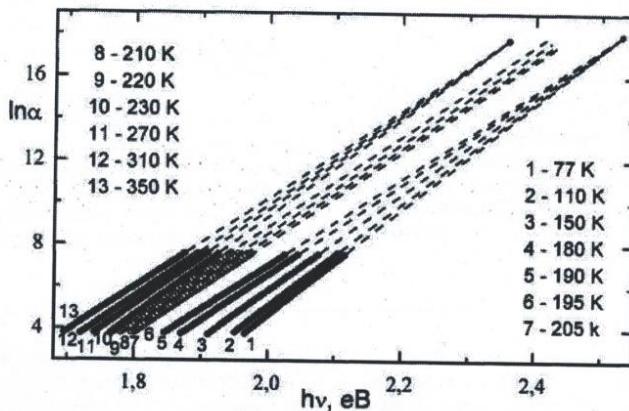
1. Kurik M.V. Urbach rule (Review) // Phys. Stat. Sol. (a). - 1971. - Vol.8, №1. - P.9-30.

2. Yang Z., Homewood K.P., Finney M.S., Harry M.A., Reeson K.J. Optical absorption study of ion beam synthesized polycrystalline semiconducting  $\text{FeSi}_2$  // J. Appl. Phys. - 1995. - Vol.78, №3. - P.1958-1963.

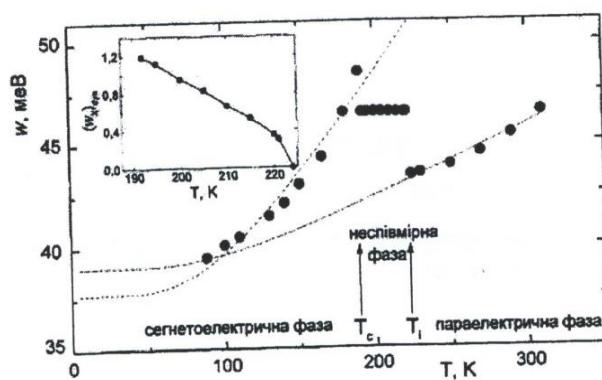
3. Cody G.D., Tiedje T., Abeles B., Brooks B., Goldstein Y. Disorder and the optical-absorption edge of hydrogenated amorphous silicon // Phys. Rev. Lett. - 1981. - Vol.47, №20. - P.1480-1483.

4. Сливка А.Г., Герзанич Е.И., Шуста В.С., Гуранич П.П. Влияние изоморфного замещения и внешнего давления на фундаментальное поглощение света кристаллами  $\text{Sn}(\text{Pb})_2\text{P}_2\text{S}(\text{Se})_6$  // Изв. Вузов. Сер.Физика. - 1999. - №9. - С.23-28.

5. Парсамян Т.К., Хасанов С.С., Шехтман В.Ш., Высочанский Ю.М., Сливка В.Ю. Несоразмерная фаза в собственном сегнетоэлектрике  $\text{Sn}_2\text{P}_2\text{Se}_6$  // Физика твердого тела. - 1985. - Т.27, №11. - С.3327-3331. - прототип.



Фіг. 1



Фіг. 2